

日本特許庁  
JAPAN PATENT OFFICE

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日      2002年12月20日  
Date of Application:

出願番号      特願2002-369954  
Application Number:

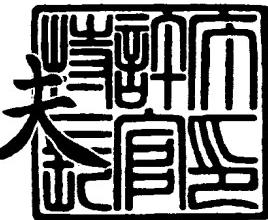
[ST. 10/C] : [JP 2002-369954]

出願人      セイコーホーリング株式会社  
Applicant(s):

2003年10月29日

特許庁長官  
Commissioner,  
Japan Patent Office

今井康夫



【書類名】 特許願  
【整理番号】 J0096379  
【提出日】 平成14年12月20日  
【あて先】 特許庁長官 殿  
【国際特許分類】 G02F 1/13  
【発明の名称】 液晶表示装置および電子機器  
【請求項の数】 8  
【発明者】  
【住所又は居所】 長野県諏訪市大和3丁目3番5号 セイコーエプソン株式会社内  
【氏名】 奥村 治  
【特許出願人】  
【識別番号】 000002369  
【氏名又は名称】 セイコーエプソン株式会社  
【代理人】  
【識別番号】 100089037  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 渡邊 隆  
【代理人】  
【識別番号】 100064908  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 志賀 正武  
【選任した代理人】  
【識別番号】 100110364  
【弁理士】  
【氏名又は名称】 実広 信哉  
【手数料の表示】  
【予納台帳番号】 008707  
【納付金額】 21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】 明細書 1

【物件名】 図面 1

【物件名】 要約書 1

【包括委任状番号】 9910485

【プルーフの要否】 要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 液晶表示装置および電子機器

【特許請求の範囲】

【請求項1】 一対の基板間に液晶層を挟持してなり、1つのドット領域内に透過表示を行う透過表示領域と反射表示を行う反射表示領域とが設けられた液晶表示装置であって、

前記液晶層は、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、前記一対の基板の前記液晶層側には該液晶を駆動するための電極がそれぞれ設けられるとともに、

前記一対の基板の電極のうちの少なくとも一方の電極には、前記透過表示領域及び前記反射表示領域のそれぞれにおいて、前記液晶の配向を規制するための配向規制手段として、電極の一部を開口して形成したスリット状の開口部、及び／又は電極上に形成された誘電体からなる凸状部が設けられ、

前記スリット状の開口部の開口面積、及び／又は誘電体の凸状部の前記基板平面方向占有面積が、前記透過表示領域よりも前記反射表示領域において大きく構成されていることを特徴とする液晶表示装置。

【請求項2】 前記一対の基板に設けられた各電極間の距離が、前記透過表示領域と前記反射表示領域とにおいて、略同一に構成されていることを特徴とする請求項1に記載の液晶表示装置。

【請求項3】 前記誘電体からなる凸状部は、前記電極上に設けられるものであって、該電極面に対して所定の角度で傾斜する傾斜面を有することを特徴とする請求項1又は2に記載の液晶表示装置。

【請求項4】 前記反射表示領域に形成された前記開口部及び／又は前記凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離が、前記透過表示領域に形成された前記開口部及び／又は前記凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離よりも小さく構成されていることを特徴とする請求項1ないし3のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項5】 前記開口部及び／又は凸状部は、前記垂直配向した液晶分子が電界変化に基づいて倒れる方向を規制する構成を具備していることを特徴とす

る請求項1ないし4のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項6】 前記一対の基板として上基板と下基板とを含み、前記下基板の液晶層と反対側には透過表示用のバックライトが設けられるとともに、該下基板の液晶層側には前記反射表示領域のみに選択的に形成された反射膜が設けられていることを特徴とする請求項1ないし5のいずれか1項に記載の液晶表示装置。

【請求項7】 前記上基板の液晶層側、又は前記反射膜の液晶層側にカラーフィルタ層が設けられていることを特徴とする請求項6に記載の液晶表示装置。

【請求項8】 請求項1ないし7のいずれか1項に記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とする電子機器。

#### 【発明の詳細な説明】

##### 【0001】

##### 【発明の属する技術分野】

本発明は、液晶表示装置および電子機器に関し、特に反射モードと透過モードの双方で表示を行う半透過反射型の液晶表示装置において、高コントラスト、広視野角の表示が得られる技術に関するものである。

##### 【0002】

##### 【従来の技術】

液晶表示装置として反射モードと透過モードとを兼ね備えた半透過反射型液晶表示装置が知られている。このような半透過反射型液晶表示装置としては、上基板と下基板との間に液晶層が挟持されるとともに、例えばアルミニウム等の金属膜に光透過用の窓部を形成した反射膜を下基板の内面に備え、この反射膜を半透過反射板として機能させるものが提案されている。この場合、反射モードでは上基板側から入射した外光が、液晶層を通過した後に下基板の内面の反射膜で反射され、再び液晶層を通過して上基板側から出射され、表示に寄与する。一方、透過モードでは下基板側から入射したバックライトからの光が、反射膜の窓部から液晶層を通過した後、上基板側から外部に出射され、表示に寄与する。したがって、反射膜の形成領域のうち、窓部が形成された領域が透過表示領域、その他の領域が反射表示領域となる。

### 【0003】

ところが、従来の半透過反射型液晶装置には、透過表示での視角が狭いという課題があった。これは、視差が生じないよう液晶セルの内面に半透過反射板を設けている関係で、観察者側に備えた1枚の偏光板だけで反射表示を行わなければならぬという制約があり、光学設計の自由度が小さいためである。そこで、この課題を解決するために、Jisakiらは、下記の非特許文献1において、垂直配向液晶を用いる新しい液晶表示装置を提案した。その特徴は、以下の3つである。

(1) 誘電異方性が負の液晶を基板に垂直に配向させ、電圧印加によってこれを倒す「VA (Vertical Alignment) モード」を採用している点。

(2) 透過表示領域と反射表示領域の液晶層厚（セルギャップ）が異なる「マルチギャップ構造」を採用している点（この点については、例えば特許文献1参照）。

(3) 透過表示領域を正八角形とし、この領域内で液晶が8方向に倒れるように対向基板上の透過表示領域の中央に突起を設けている点。すなわち、「配向分割構造」を採用している点。

### 【0004】

#### 【特許文献1】

特開平11-242226号公報

#### 【非特許文献1】

"Development of transreflective LCD for high contrast and wide viewing angle by using homeotropic alignment", M. Jisaki et al., Asia Display/IDW'01, p. 133-136(2001)

### 【0005】

#### 【発明が解決しようとする課題】

ところが、Jisakiらの論文においては、透過表示領域の液晶が倒れる方向については突起を用いて制御しているが、反射表示領域については液晶が倒れる方向を制御するための構成は全く存在しない。したがって、反射表示領域では液晶が無秩序な方向に倒れることになり、その場合、異なる液晶配向領域の境界にディスクリネーションと呼ばれる不連続線が現れ、これが残像等の原因になる。また

、液晶の各々の配向領域は異なる視角特性を有するため、斜め方向から液晶装置を見たときに、ざらざらとしたしみ状のむらとして見えるという問題も生じる。

#### 【0006】

一方、半透過反射型液晶表示装置において上記のようなマルチギャップ構造を具備させることは、透過表示領域と反射表示領域の電気光学特性（透過率－電圧特性、反射率－電圧特性）を揃える上で非常に有効である。なぜならば、透過表示領域では光が液晶層を1回しか通らないが、反射表示領域では光が液晶層を2回通るからである。

#### 【0007】

図12にマルチギャップ構造が電気光学特性（透過率－電圧特性、反射率－電圧特性）に及ぼす効果を示す。図12（a）は透過表示領域と反射表示領域の液晶層厚が等しい場合の電気光学特性である。このようなマルチギャップ構造をとらない液晶表示装置の場合には、反射表示の反射率－電圧特性が急峻過ぎて、透過表示領域と反射表示領域を異なる電圧で駆動しない限り、透過率の低下、反射表示の中間調反転といった表示上の問題を生じる。一方、図12（b）は透過表示領域の液晶層厚を反射表示領域の液晶層厚の約2倍にした場合の電気光学特性である。このようなマルチギャップ構造を取ると、反射表示の反射率－電圧特性が略一致するため、同じ電圧で駆動することが出来るようになる。

#### 【0008】

しかしながら、このようなマルチギャップ構造を具備させると、液晶層厚を異ならしめている段差領域の液晶分子が動き難いために実質的な開口率を低下させるという問題が生じる場合がある。また製造工程上、マルチギャップ構造を得るためにフォトプロセスが余分に必要であるため、コストアップに繋がる問題もある。

#### 【0009】

本発明は、上記の課題を解決するためになされたものであって、半透過反射型の液晶表示装置において、残像やしみ状のむら等の表示不良が抑えられ、さらには広視野角の表示が可能であるとともに、マルチギャップ構造を具備させたような場合の段差による開口率の低下等も生じ難い液晶表示装置を提供することを目

的とする。また、反射表示を行う領域において液晶が倒れる方向を制御するための簡便で且つ好適な手法を提供し、反射表示及び透過表示の双方において表示が均一で且つ視角の広い液晶表示装置を提供することを目的とする。

### 【0010】

#### 【課題を解決するための手段】

上記の目的を達成するために、本発明の液晶表示装置は、一対の基板間に液晶層を挟持してなり、1つのドット領域内に透過表示を行う透過表示領域と反射表示を行う反射表示領域とが設けられた液晶表示装置であって、前記液晶層は、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、前記一対の基板の前記液晶層側には該液晶を駆動するための電極がそれぞれ設けられるとともに、前記一対の基板の電極のうちの少なくとも一方の電極には、前記透過表示領域及び前記反射表示領域のそれぞれにおいて、前記液晶の配向を規制するための配向規制手段として、電極の一部を開口して形成したスリット状の開口部、及び／又は電極上に形成された誘電体からなる凸状部が設けられ、前記スリット状の開口部の開口面積、及び／又は誘電体の凸状部の前記基板平面方向占有面積が、前記透過表示領域よりも前記反射表示領域において大きく構成されていることを特徴とする。

### 【0011】

本発明の液晶表示装置は、半透過反射型液晶表示装置に垂直配向モードの液晶を組み合わせたものであって、特に垂直配向モードの液晶における電界印加時の配向方向を制御するための好ましい構成を見い出したものである。垂直配向モードを採用した場合には一般にネガ型液晶を用いるが、初期配向状態で液晶分子が基板面に対して垂直に立っているものを、電界印加により倒すわけであるから、何も工夫をしなければ（プレチルトが付与されていなければ）液晶分子の倒れる方向を制御できず、配向の乱れ（ディスクリネーション）が生じて光抜け等の表示不良が生じ、表示品位を落としてしまう。そのため、垂直配向モードの採用にあたっては、電界印加時の液晶分子の配向方向の制御が重要な要素となる。

そこで、本発明の液晶表示装置においては、透過表示領域及び反射表示領域のそれについて、液晶の配向規制手段として、電極にスリット状の開口部を形

成する、及び／又は電極上に誘電体（例えば樹脂等）からなる凸状部を形成した。その結果、液晶分子が初期状態で垂直配向を呈した上で、この開口部及び／又は凸状部の形状に応じたプレチルトを持つようになる。その結果、液晶分子の倒れる方向を規制ないし制御することが可能となり、配向の乱れ（ディスクリネーション）が生じ難く、光抜け等の表示不良を回避することが可能となり、残像やしみ状のむら等の表示不良が抑えられ、さらには視野角の広い液晶表示装置を提供することが可能となった。

また、特に反射表示領域における開口部の開口面積、及び／又は凸状部の基板平面方向占有面積を、透過表示領域における開口部の開口面積、及び／又は凸状部の基板平面方向占有面積よりも大きく構成したために、反射表示領域において液晶層に電圧がかかり難くなり、該反射表示領域においては高い電圧を印加しないと液晶分子が電圧の方向に倒れないようになる。したがって、従来の技術で示したようなマルチギャップ構造を取らずとも、図4に示すように反射表示の電気光学特性を透過表示の電気光学特性に揃えることが可能となる。

つまり、本発明によると、上述のような液晶配向規制効果に基づく広視野角表示の獲得とともに、簡便な構成で反射表示領域と透過表示領域の液晶を同一電圧で同一駆動させることができ、電気光学特性に優れた液晶表示装置を提供することが可能となるのである。

### 【0012】

ここで、前記開口部及び／又は凸状部は、前記垂直配向した液晶分子の倒れる方向を規制する構成を具備しているものとすることができ、この場合、垂直配向した液晶分子を所定方向に対し規則的に倒れるようにすることができる。その結果、液晶分子の配向の乱れ（ディスクリネーション）が生じ難く、光抜け等の表示不良を回避することが可能となり、表示特性の高い液晶表示装置を提供することができる。なお、液晶分子の倒れる方向を規制する構成としては、具体的には開口部及び／又は凸状部の表面を液晶分子の垂直配向方向に対して所定の角度だけ傾斜するように構成するものとすることができる。

### 【0013】

なお、前記一対の基板に設けられた各電極間の距離は、前記透過表示領域と前

記反射表示領域とにおいて、略同一に構成されているものとすることができます。なお、この場合の電極間距離は、開口部及び／又は凸状部を形成していない領域の各基板の電極間距離を言うものとする。本発明の液晶表示装置では、このように電極間距離が透過表示領域と反射表示領域とで略同一の場合にも、各表示領域の電気光学特性を揃えることができるようになる。また、反射表示を得るためにいずれかの基板上に反射膜を具備させた場合には、その反射膜の膜厚程度は異なっていても本発明の効果を発現することが可能である。

#### 【0014】

また、前記誘電体からなる凸状部は、前記電極上に設けられるものであって、該電極面に対して所定の角度で傾斜する傾斜面を有するものとすることができる。このように凸状部が傾斜面を備えると、その傾斜面に沿った方向に液晶分子の倒れる方向を規制することが可能となり好適である。

#### 【0015】

さらに、前記反射表示領域に形成された前記開口部及び／又は前記凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離が、前記透過表示領域に形成された前記開口部及び／又は前記凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離よりも小さく構成されているものとすることもできる。このような構成の場合、好適に反射表示領域の開口部及び／又は凸状部の面積比率を、透過表示領域のそれよりも高めることが可能となる。

#### 【0016】

また、本発明の液晶表示装置においては、前記一対の基板として上基板と下基板とを含み、前記下基板の液晶層と反対側には透過表示用のバックライトが設けられるとともに、該下基板の液晶層側には前記反射表示領域のみに選択的に形成された反射膜が設けられているものとすることができます。このような構成により好適に半透過反射型の液晶表示装置を提供することができる。さらには、前記上基板の液晶層側、又は前記反射膜の液晶層側にカラーフィルタ層を設けることでき、好適にカラー表示可能な半透過反射型液晶表示装置を提供できるようになる。

#### 【0017】

次に、本発明の電子機器は、上記記載の液晶表示装置を備えたことを特徴とす

る。このような電子機器によると、残像やしみ状のむら等の表示不良が抑えられ、さらには視野角の広い表示特性に優れた表示部を備えた電子機器を提供することが可能となる。

### 【0018】

#### 【発明の実施の形態】

##### [第1の実施の形態]

以下、本発明の第1の実施の形態を図面を参照して説明する。

本実施の形態の液晶表示装置は、スイッチング素子として薄膜トランジスタ（Thin Film Transistor, 以下、TFTと略記する）を用いたアクティブマトリクス型の液晶表示装置の例である。

### 【0019】

図1は本実施の形態の液晶表示装置の画像表示領域を構成するマトリクス状に配置された複数のドットの等価回路図、図2はTFTアレイ基板の相隣接する複数のドットの構造を示す平面図、図3は同、液晶装置の構造を示す平面図（上段）及び断面図（下段）である。なお、以下の各図においては、各層や各部材を図面上で認識可能な程度の大きさとするため、各層や各部材毎に縮尺を異ならせてある。

### 【0020】

本実施の形態の液晶表示装置において、図1に示すように、画像表示領域を構成するマトリクス状に配置された複数のドットには、画素電極9と当該画素電極9を制御するためのスイッチング素子であるTFT30がそれぞれ形成されており、画像信号が供給されるデータ線6aが当該TFT30のソースに電気的に接続されている。データ線6aに書き込む画像信号S1、S2、…、Snは、この順に線順次に供給されるか、あるいは相隣接する複数のデータ線6aに対してグループ毎に供給される。また、走査線3aがTFT30のゲートに電気的に接続されており、複数の走査線3aに対して走査信号G1、G2、…、Gmが所定のタイミングでパルス的に線順次で印加される。また、画素電極9はTFT30のドレインに電気的に接続されており、スイッチング素子であるTFT30を一定期間だけオンすることにより、データ線6aから供給される画像信号S1、S2

、…、S<sub>n</sub>を所定のタイミングで書き込む。

#### 【0021】

画素電極9を介して液晶に書き込まれた所定レベルの画像信号S1、S2、…、S<sub>n</sub>は、後述する共通電極との間で一定期間保持される。液晶は、印加される電圧レベルにより分子集合の配向や秩序が変化することにより、光を変調し、階調表示を可能にする。ここで、保持された画像信号がリークすることを防止するために、画素電極9と共通電極との間に形成される液晶容量と並列に蓄積容量70が付加されている。なお、符号3bは容量線である。

#### 【0022】

次に、図2に基づいて、本実施の形態の液晶装置を構成するTFTアレイ基板の平面構造について説明する。

図2に示すように、TFTアレイ基板上に、複数の矩形状の画素電極9（点線部9Aにより輪郭を示す）がマトリクス状に設けられており、画素電極9の縦横の境界に各々沿ってデータ線6a、走査線3aおよび容量線3bが設けられている。本実施の形態において、各画素電極9および各画素電極9を囲むように配設されたデータ線6a、走査線3a、容量線3b等が形成された領域の内側が一つのドット領域であり、マトリクス状に配置された各ドット領域毎に表示が可能な構造になっている。

#### 【0023】

データ線6aは、TFT30を構成する、例えばポリシリコン膜からなる半導体層1aのうち、後述のソース領域にコンタクトホール5を介して電気的に接続されており、画素電極9は、半導体層1aのうち、後述のドレイン領域にコンタクトホール8を介して電気的に接続されている。また、半導体層1aのうち、チャネル領域（図中左上がりの斜線の領域）に対向するように走査線3aが配置されており、走査線3aはチャネル領域に対向する部分でゲート電極として機能する。

#### 【0024】

容量線3bは、走査線3aに沿って略直線状に延びる本線部（すなわち、平面的に見て、走査線3aに沿って形成された第1領域）と、データ線6aと交差す

る箇所からデータ線6aに沿って前段側（図中上向き）に突出した突出部（すなわち、平面的に見て、データ線6aに沿って延設された第2領域）とを有する。そして、図2中、右上がりの斜線で示した領域には、複数の第1遮光膜11aが設けられている。

#### 【0025】

より具体的には、第1遮光膜11aは、各々、半導体層1aのチャネル領域を含むTFT30をTFTアレイ基板側から見て覆う位置に設けられており、さらに、容量線3bの本線部に対向して走査線3aに沿って直線状に延びる本線部と、データ線6aと交差する箇所からデータ線6aに沿って隣接する後段側（すなわち、図中下向き）に突出した突出部とを有する。第1遮光膜11aの各段（画素行）における下向きの突出部の先端は、データ線6a下において次段における容量線3bの上向きの突出部の先端と重なっている。この重なった箇所には、第1遮光膜11aと容量線3bとを相互に電気的に接続するコンタクトホール13が設けられている。すなわち、本実施の形態では、第1遮光膜11aは、コンタクトホール13によって前段あるいは後段の容量線3bに電気的に接続されている。

#### 【0026】

また、図2に示すように、一つのドット領域の中央部には反射膜20が形成されており、この反射膜20が形成された領域が反射表示領域Rとなり、その反射膜20が形成されていない領域、すなわち反射膜20の開口部21内が透過表示領域Tとなる。

#### 【0027】

次に、図3に基づいて本実施の形態の液晶表示装置の構造について説明する。図3(a)は本実施の形態の液晶表示装置に備えられたカラーフィルタ層の平面構造を示す平面模式図で、図3(b)は図3(a)の平面図のうち赤色の着色層に対応する部分の断面模式図である。

#### 【0028】

本実施の形態の液晶表示装置は、図2に示したようにデータ線6a、走査線3a、容量線3b等にて囲まれた領域の内側に画素電極9を備えてなるドット領域

を有している。このドット領域内には、図3（a）に示すように一のドット領域（D1, D2, D3のいずれか）に対応して3原色のうちの一の着色層が配設され、3つのドット領域D1, D2, D3で各着色層22B（青色）、22G（緑色）、22R（赤色）を含む画素を形成している。

#### 【0029】

一方、図3（b）に示すように、本実施の形態の液晶表示装置は、TFTアレイ基板10とこれに対向配置された対向基板25との間に初期配向状態が垂直配向をとる液晶、すなわち誘電率異方性が負の液晶材料からなる液晶層50が挟持されている。TFTアレイ基板10は、石英、ガラス等の透光性材料からなる基板本体10Aの表面にアルミニウム、銀等の反射率の高い金属膜からなる反射膜20が絶縁膜24を介して部分的に形成された構成をなしている。上述したように、反射膜20の形成領域が反射表示領域Rとなり、反射膜20の非形成領域、すなわち反射膜20の開口部（透光部）21内が透過表示領域Tとなる。このように本実施の形態の液晶表示装置は、垂直配向型の液晶層を備える垂直配向型液晶表示装置であって、反射表示及び透過表示を可能にした半透過反射型の液晶表示装置である。なお、絶縁層24の表面は凹凸形状とされており、その凹凸形状に倣って反射膜20の表面は凹凸状部を有する。このような凹凸により反射光が散乱されるため、外部からの映り込みが防止され、広視野角の表示を得ることが可能とされている。また、透過表示領域は必ずしも反射膜20を開口した領域である必要がなく、例えば部分的に反射膜20の膜厚を薄くした等の透光手段を施した領域に設計することも可能である。

#### 【0030】

反射膜20の表面を含む絶縁膜24の表面には、インジウム錫酸化物（Indium Tin Oxide, 以下、ITOと略記する）等の透明導電膜からなる画素電極9、ポリイミド等からなる配向膜（図示略）が形成されている。なお、本実施の形態では、反射膜20と画素電極9とを別個に設けて積層したが、反射表示領域Rにおいては金属膜からなる反射膜を画素電極として用いることも可能である。

#### 【0031】

一方、対向基板25側は、ガラスや石英等の透光性材料からなる基板本体25

A上（基板本体25Aの液晶層側）に、カラーフィルタ22（図3（b）では赤色着色層22R）が設けられている。また、着色層22Rの周縁はブラックマトリクスBMにて囲まれ、ブラックマトリクスBMにより各ドット領域D1, D2、D3の境界が形成されている。また、カラーフィルタ層22の更に液晶層側には、ITO等の透明導電膜からなる共通電極31、ポリイミド等からなる配向膜（図示略）が形成されている。

#### 【0032】

なお、TFTアレイ基板10、対向基板25の双方の配向膜には、ともに垂直配向処理が施されている。さらに、TFTアレイ基板10の外面側には位相差板18及び偏光板19が、対向基板25の外面側にも位相差板16及び偏光板17が形成されており、基板内面側に円偏光を入射可能に構成されている。偏光板17（19）と位相差板16（18）の構成としては、偏光板と $\lambda/4$ 位相差板を組み合わせた円偏光板、若しくは偏光板と $\lambda/2$ 位相差板と $\lambda/4$ 位相差板を組み合わせた広帯域円偏光板、又は偏光板と $\lambda/2$ 位相差板と $\lambda/4$ 位相差板と負のCプレート（膜厚方向に光軸を有する位相差板）からなる視角補償板を採用することができる。なお、TFTアレイ基板10に形成された偏光板19の外側には透過表示用の光源たるバックライト15が設けられている。

#### 【0033】

そして本実施の形態の液晶表示装置では、液晶層50の配向制御を司る前記一对の電極のうちの少なくとも一方に、透過表示領域T及び反射表示領域Rのそれぞれにおいて、電極の一部を開口して形成したスリット状の開口部41, 42、若しくは電極上に形成された誘電体からなる凸状部43, 44が設けられている。詳しくは、画素電極9には、透過表示領域Tにスリット状の開口部41が、反射表示領域Rにスリット状の開口部42がそれぞれ形成され、共通電極31には、透過表示領域Tに凸状部43が、反射表示領域Rに凸状部44が凸設されている。

#### 【0034】

このように液晶層50の挟持面に形成した開口部41, 42や凸状部43, 44は、初期状態で垂直配向した液晶分子の電界変化に基づき倒れる方向を規制し

ている。つまり、電極（この場合、画素電極9）に開口部41，42を形成することにより、電極間の電界方向が基板垂直方向から傾くため、その傾きに沿って液晶分子が倒れる方向が指向され、一方、電極（この場合、共通電極31）に凸状部43，44を形成することにより、その凸状部が備える傾斜面に液晶分子が垂直配向することにより液晶分子の倒れる方向が指向されることとなる。ここでの、凸状部43，44は、例えば所定の傾斜面を有し、長手方向に延びる凸条形状を有しているが、これに限定されることなく、液晶分子の倒れる方向を規制する面を具備していれば良い。

### 【0035】

したがって、透過表示領域T及び反射表示領域Rの双方において、液晶分子の配向、特に初期状態で垂直配向した液晶分子の倒れる方向を規制することが可能となった。その結果、非常に広い視角特性が得られるようになった。具体的に、反射表示では $120^\circ$ コーンで1:10以上のコントラストが得られ、透過表示では $160^\circ$ コーンで1:10以上のコントラストが得られた。

### 【0036】

本実施の形態の液晶表示装置では、透過表示領域Tの液晶層厚と反射表示領域Rの液晶層厚とが略同じとなる構成とされており、具体的には反射膜20の膜厚だけ透過表示領域Tの液晶層厚が大きくなっている。また、画素電極9に形成された開口部41，42について、図3（a）の平面図に示すように、反射表示領域Rに形成された開口部42の開口幅（開口面積）が、透過表示領域Tに形成された開口部41の開口幅（開口面積）よりも大きく構成されている。さらに、共通電極31に設けられた樹脂性の凸状部43，44について、同じく図3（a）の平面図に示すように、反射表示領域Rに形成された凸状部44の幅が、透過表示領域Tに形成された凸状部43の幅よりも大きく構成されている。

### 【0037】

具体的には、反射表示領域Rに形成された開口部42の開口幅が約 $8\mu m$ 、凸状部44の幅が約 $12\mu m$ とされる一方、透過表示領域Tに形成された開口部41の開口幅が約 $5\mu m$ 、凸状部43の幅が約 $6\mu m$ とされている。また、これら開口部及び凸状部の各領域において占める面積、すなわち基板面内の占有面積は

、反射表示領域Rにおいて約35%、透過表示領域Tにおいて約19%とされている。

#### 【0038】

このような開口部41, 42や凸状部43, 44が形成された領域では、液晶層50に電圧がかかり難く、高い電圧を印加しないと液晶分子が電圧変化に基づいて倒れないようになる。本実施の形態では、反射表示領域Rにおける開口部及び凸状部の占有面積を、透過表示領域Tのものよりも大きくしたため、該反射表示領域Rの液晶分子を動作させるには、相対的に高い電圧が必要になる。

#### 【0039】

ここで、従来の技術で示した通り、半透過反射型の液晶表示装置では、マルチギャップ構造をとらないと、反射表示の反射率-電圧特性が急峻過ぎるという問題があった（図12（a）参照）。しかしながら、本実施の形態のように、半透過反射型の液晶表示装置で、マルチギャップ構造をとらない場合にも、液晶分子の配向規制を行う開口部及び／又は凸状部の占有面積を反射表示領域Rにおいて相対的に大きくすることで、上述のように反射表示領域Rの液晶分子を動作させる電圧を相対的に大きく必要となり、図4に示すように反射表示の反射率-電圧特性を略一致させることができた。

#### 【0040】

したがって、本実施の形態の液晶表示装置によると、透過表示領域T及び反射表示領域Rの双方において、液晶分子の配向、特に初期状態で垂直配向した液晶分子の倒れる方向を規制することが可能となり、各領域において非常に広い視角特性が得られるようになった。さらに、この液晶分子の配向を規制する手段（開口部及び／又は凸状部）を利用して、その面内占有面積を各領域で異ならしめ、各領域の電気光学特性を略一致させたため、反射表示と透過表示とを同じ電圧で駆動することができるようになった。

#### 【0041】

なお、凸状部43, 44の幅（平面内占有面積）は、さらに大きくしても問題ないが、開口部41, 42の幅（開口面積）を大きくし過ぎると、いくら電圧を上げても開口部の中央付近の液晶分子が動作しなくなり、表示が暗くなる等の不

具合が生じる場合がある。

#### 【0042】

##### [第2の実施の形態]

以下、本発明の第2の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。

図5は、第2の実施の形態の液晶表示装置について、平面図及び断面図を示すもので第1の実施の形態の図3に相当する模式図である。本実施の形態の液晶表示装置の基本構成は第1の実施の形態と同様であり、画素電極9の反射表示領域R及び透過表示領域Tに開口部41，42が、共通電極31の反射表示領域R及び透過表示領域Tに凸状部43，44が設けられている。しかしながら、この第2の実施の形態では、樹脂製の絶縁膜24を透過表示領域Tにおいて形成していない点、つまり反射表示領域Rに選択的に散乱用の凹凸表面を有した絶縁膜24を形成した点が第1の実施の形態と異なっている。

#### 【0043】

このような構成によると、反射膜20の厚み0.2μmと絶縁層24の平均厚み0.5μmを足した0.7μm分だけ、透過表示領域の液晶層厚が反射表示領域の液晶層厚よりも大きくなる。反射表示の反射率-電圧特性と、透過表示の透過率-電圧特性を揃えるためには、2μm程度の液晶層厚差が必要であり、0.7μm程度では不十分であるが、これに第1の実施の形態と同様、開口部及び／又は凸状部の構成について面積比率を反射表示領域において大きくすることで、その不十分さを補うことが可能である。

#### 【0044】

なお、第2の実施の形態では、反射表示領域Rに形成した開口部42の開口幅は約6μm、凸状部44の幅は約10μmとされ、透過表示領域Tに形成した開口部41の開口幅は約5μm、凸状部44の幅は約6μmとされている。この場合、反射表示領域Rの開口部及び凸状部の面内占有面積比率は約28%、透過表示領域Tの開口部及び凸状部の面内占有面積比率は約19%となる。

#### 【0045】

このように第2の実施の形態の場合、反射表示領域Rと透過表示領域Tとの液晶層厚差が0.7μmであるために、各領域における面積比率の差を第1の実施

の形態よりも小さくした場合にも、反射表示領域Rと透過表示領域Tの電気光学特性を揃えることが出来た。また、透過表示領域Tに絶縁層24がない分だけ明るい透過表示を得ることができた。

#### 【0046】

##### [第3の実施の形態]

以下、本発明の第3の実施の形態を図6を参照して説明する。

図6は、第3の実施の形態の液晶表示装置について、平面図及び断面図を示すもので第1の実施の形態の図3に相当する模式図である。本実施の形態の液晶表示装置は、対向基板25側の共通電極（対向電極）31に凸状部を形成せず、開口部45, 46をそれぞれ反射表示領域Rと透過表示領域Tについて形成したことが第1の実施の形態とは異なり、その他の構成は第1の実施の形態と概略同様であるため、図6において図3と共通の構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。

#### 【0047】

本実施の形態において、画素電極9に形成した開口部の開口幅は、反射表示領域Rでは約 $7\mu\text{m}$ 、透過表示領域Tでは約 $5\mu\text{m}$ であり、共通電極（対向電極）31に形成した開口部の開口幅は、反射表示領域Rでは約 $7\mu\text{m}$ 、透過表示領域Tでは約 $5\mu\text{m}$ である。そして、反射表示領域Rにおける開口部の開口面積比率は約25%、透過表示領域Tにおける開口部の開口面積比率は約18%である。

#### 【0048】

以上のような構成の液晶表示装置においても、反射表示領域Rと透過表示領域Tの電気光学特性を揃えることができた。また、画素電極9及び共通電極（対向電極）31の双方において電極のパターニングが必要な単純マトリクス方式や、TFD（薄膜ダイオード）を用いたアクティブマトリクス方式のものを採用した液晶表示装置について、この第2の実施の形態の構成を採用した場合、第1の実施の形態を採用する場合に比して、製造プロセスにおけるフォト工程が一つ減り、簡便で低コスト化を実現することができるようになる。

#### 【0049】

なお、電極に形成する開口部と凸状部の組み合わせについては、共通電極（上

基板) に開口部、画素電極(下基板) に凸状部を形成した構成、あるいは共通電極(上基板) 及び画素電極(下基板) 共に凸状部を形成した構成、あるいは共通電極(上基板) 又は画素電極(下基板) のみに開口部を形成した構成、あるいは共通電極(上基板) 又は画素電極(下基板) のみに凸状部を形成した構成のいずれを採用することも可能である。

### 【0050】

#### [第4の実施の形態]

以下、本発明の第4の実施の形態を図7を参照して説明する。

図7は、第4の実施の形態の液晶表示装置について、平面図及び断面図を示すもので第1の実施の形態の図3に相当する模式図である。本実施の形態の液晶表示装置は、反射表示領域Rに形成した開口部及び／又は凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離を、透過表示領域Tに形成した開口部及び／又は凸状部のうち隣接する開口部及び／又は凸状部間の距離よりも小さく構成した。すなわち、反射表示領域Rと透過表示領域Tとで、開口部間ピッチ及び／凸状部間ピッチを異なる構成とし、開口部の幅と凸状部の幅は各領域で同一とした。なお、その他の構成は第1の実施の形態と概略同様であるため、図7において図3と共に構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。

### 【0051】

本実施の形態において、画素電極9に形成した開口部の開口幅は、反射表示領域R及び透過表示領域Tとともに約 $5\mu m$ であり、共通電極(対向電極)31に形成した凸状部の幅は、反射表示領域R及び透過表示領域Tとともに約 $6\mu m$ である。また、反射表示領域Rに形成した凸状部44aと隣接する凸状部44bとの間の距離(ピッチ)は約 $17\mu m$ で、透過表示領域Tに形成した凸状部43aと隣接する凸状部43bとの間の距離(ピッチ)は約 $34\mu m$ である。そして、反射表示領域Rにおける開口部及び凸状部の面積比率は約38%、透過表示領域Tにおける開口部及び凸状部の面積比率は約19%である。

### 【0052】

以上のような構成の液晶表示装置においても、反射表示領域Rと透過表示領域Tの電気光学特性を揃えることができた。また、本実施の形態のように、開口部

や凸状部の幅が一定である方が、製造プロセスにおけるフォト工程を簡便化することが可能となる。

### 【0053】

#### [第5の実施の形態]

以下、本発明の第5の実施の形態を図8を参照して説明する。

図8は、第5の実施の形態の液晶表示装置について平面図を示すもので第4の実施の形態の図7(a)に相当する模式図である。第7の実施の形態では、反射表示領域Rと透過表示領域Tとで、液晶分子の倒れる方向が異なっていた。これは視角特性の非対称の原因となり得る。そこで、本実施の形態の液晶表示装置では、図8に示すように、画素内において各表示領域R, Tの開口部及び／又は凸状部の形状を対称的にすることで、液晶分子の倒れる方向を各表示領域R, Tにおいて略同一とすることができた。すなわち、画素内において開口部及び／又は凸状部の延びる方向に反射表示領域Rと透過表示領域Tとを区分けし、その延びる方向に少なくとも該反射表示領域Rと透過表示領域Tと備える構成としたことで、液晶分子の倒れる方向を左右略対称とすることができるようになった。

### 【0054】

ここで、本実施の形態では画素電極及び共通電極のそれぞれについて開口部のみを形成するものとした。すなわち、図8において開口部Aは共通電極側に形成された開口部で、開口部Bは画素電極側に形成された開口部である。また、第4の実施の形態と同様に透過表示流域Tと反射表示領域Rとで開口部のピッチを異ならせるものとした。上述したように、幅を大きくすると不具合の生じ易い開口部を形成する場合は、ピッチを調整することで面積比率を調整することが好ましい。なお、その他の構成は第4の実施の形態と概略同様であるため、図8において図7と共に構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。

### 【0055】

また、本実施の形態において、画素電極9に形成した開口部の開口幅は、反射表示領域R及び透過表示領域Tとともに約 $5\mu m$ であり、共通電極(対向電極)31に形成した開口部の開口幅は、反射表示領域R及び透過表示領域Tとともに約 $5\mu m$ である。また、反射表示領域Rに形成した一の開口部と隣接する開口部との

間の距離（ピッチ）は約 $17\mu\text{m}$ で、透過表示領域Tに形成した開口部間の距離（ピッチ）は約 $34\mu\text{m}$ である。そして、反射表示領域Rにおける開口部の面積比率は約36%、透過表示領域Tにおける開口部の面積比率は約18%である。

### 【0056】

以上のような構成の液晶表示装置においても、反射表示領域Rと透過表示領域Tの電気光学特性を揃えることができた。また、反射表示領域R及び透過表示領域Tの双方において、上下左右対称な視角特性を得ることができた。

### 【0057】

#### [第6の実施の形態]

以下、本発明の第6の実施の形態を図9を参照して説明する。

図9は、第6の実施の形態の液晶表示装置について、平面図及び断面図を示すもので第1の実施の形態の図3に相当する模式図である。本実施の形態の液晶表示装置は、透過表示領域Tがドット（D1, D2, D3）の中央にあり、その中央に樹脂製の凸状部47を形成し、ドット周囲の反射表示領域R内にスリット状の開口部48を形成した。ここで、透過表示領域Tに配設された画素電極と、反射表示領域Rに配設された画素電極とは2ヶ所のブリッジで接続されている。なお、その他の構成は第1の実施の形態と概略同様であるため、図9において図3と共に構成要素には同一の符号を付し、詳細な説明は省略する。

### 【0058】

本実施の形態において、反射表示領域Rにおける開口部48の面積比率は約19%、透過表示領域Tにおける凸状部47の面積比率は約6%である。以上のような構成の液晶表示装置においても、反射表示領域Rと透過表示領域Tの電気光学特性を揃えることができた。また、本実施の形態の場合、もともと多少の段差があつて配向が乱れ易い透過表示領域Tと反射表示領域Rの境界領域に開口部48を設けることで、液晶分子が倒れる方向を制御し易くなるという利点も有している。なお、図10に示すように、凸状部57を画素電極9側に形成し、開口部58を共通電極31側に形成した場合も、本実施の形態と同様の効果を奏するものとなる。また、図9及び図10では凸状部47, 57として四角錐形状のものを示したが、円錐形状等の所定の傾斜面を具備したものを探用することが可能で

ある。

### 【0059】

#### [電子機器]

次に、本発明の上記実施の形態の液晶表示装置を備えた電子機器の具体例について説明する。

図11は、携帯電話の一例を示した斜視図である。図11において、符号100は携帯電話本体を示し、符号1001は上記液晶表示装置を用いた表示部を示している。このような携帯電話等の電子機器の表示部に、上記実施の形態の液晶表示装置を用いた場合、使用環境によらずに明るく、コントラストが高く、広視野角の液晶表示部を備えた電子機器を実現することができる。

### 【0060】

なお、本発明の技術範囲は上記実施の形態に限定されるものではなく、本発明の趣旨を逸脱しない範囲において種々の変更を加えることが可能である。例えば上記実施の形態ではTFTをスイッチング素子としたアクティブマトリクス型液晶表示装置に本発明を適用した例を示したが、薄膜ダイオード（Thin Film Diode, TFD）スイッチング素子としたアクティブマトリクス型液晶表示装置、パッシブマトリクス型液晶表示装置などに本発明を適用することも可能である。その他、各種構成要素の材料、寸法、形状等に関する具体的な記載は、適宜変更が可能である。

#### 【図面の簡単な説明】

【図1】 本発明の第1の実施の形態の液晶表示装置の等価回路図。

【図2】 同、液晶表示装置のドットの構造を示す平面図。

【図3】 同、液晶表示装置の要部を示す平面模式図及び断面模式図。

【図4】 同、液晶表示装置の電気光学特性を示すグラフ。

【図5】 第2の実施の形態の液晶表示装置の要部を示す平面模式図及び断面模式図。

【図6】 第3の実施の形態の液晶表示装置の要部を示す平面模式図及び断面模式図。

【図7】 第4の実施の形態の液晶表示装置の要部を示す平面模式図及び断

面模式図。

【図8】 第5の実施の形態の液晶表示装置の要部を示す平面模式図。

【図9】 第6の実施の形態の液晶表示装置の要部を示す平面模式図及び断面模式図。

【図10】 図9の液晶表示装置の変形例を示す断面模式図。

【図11】 本発明の電子機器の一例を示す斜視図。

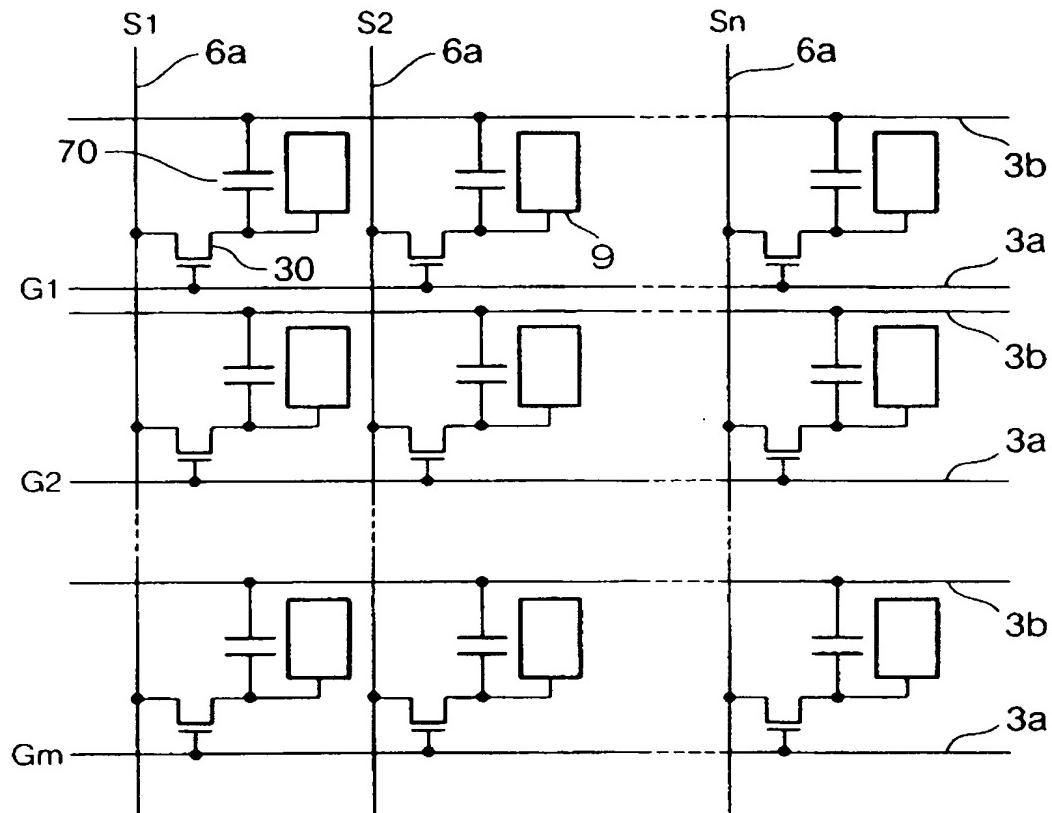
【図12】 従来の液晶表示装置の電気光学特性を示すグラフ。

【符号の説明】

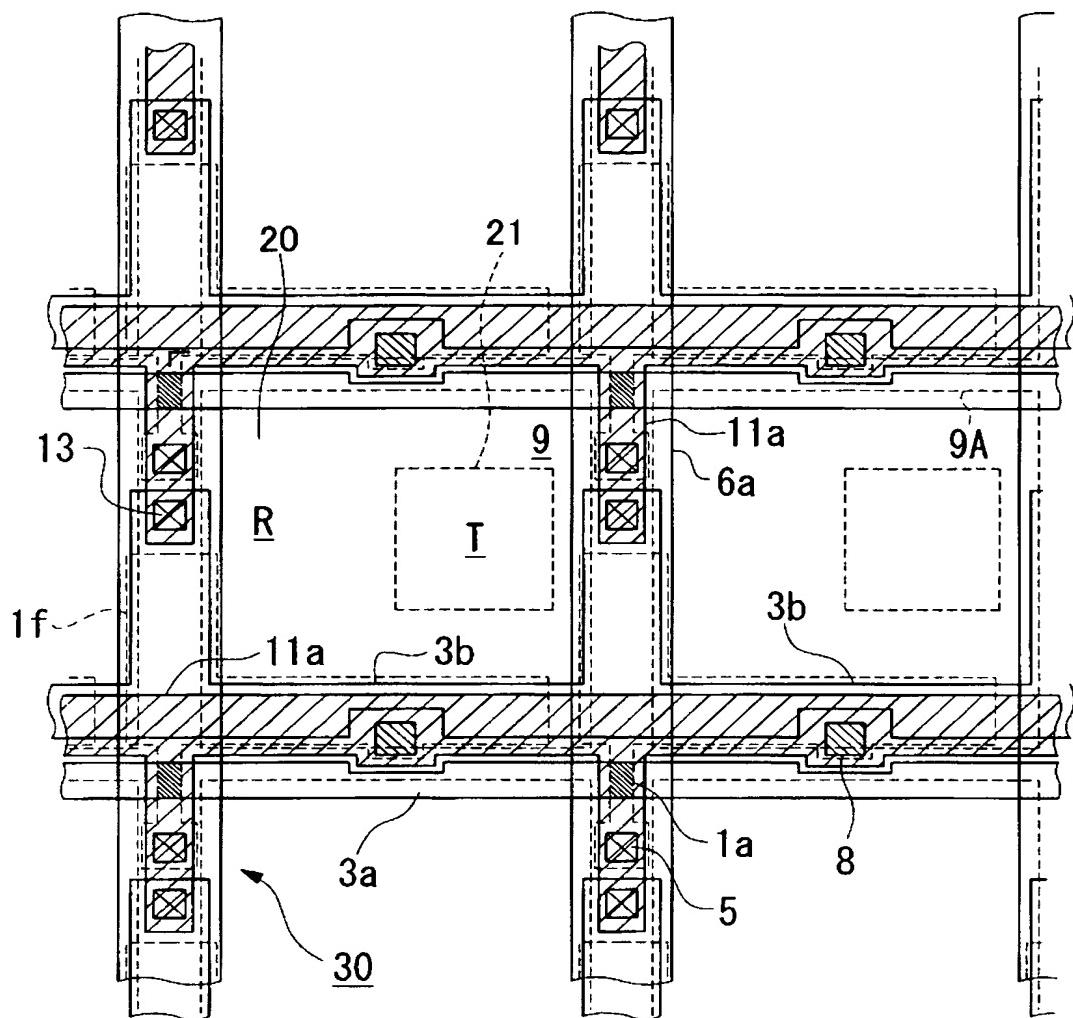
9…画素電極、10…TFTアレイ基板、20…反射膜、22…カラーフィルタ層、25…対向基板、31…共通電極、41, 42…開口部、43, 44…凸状部、50…液晶層、R…反射表示領域、T…透過表示領域

【書類名】 図面

【図1】

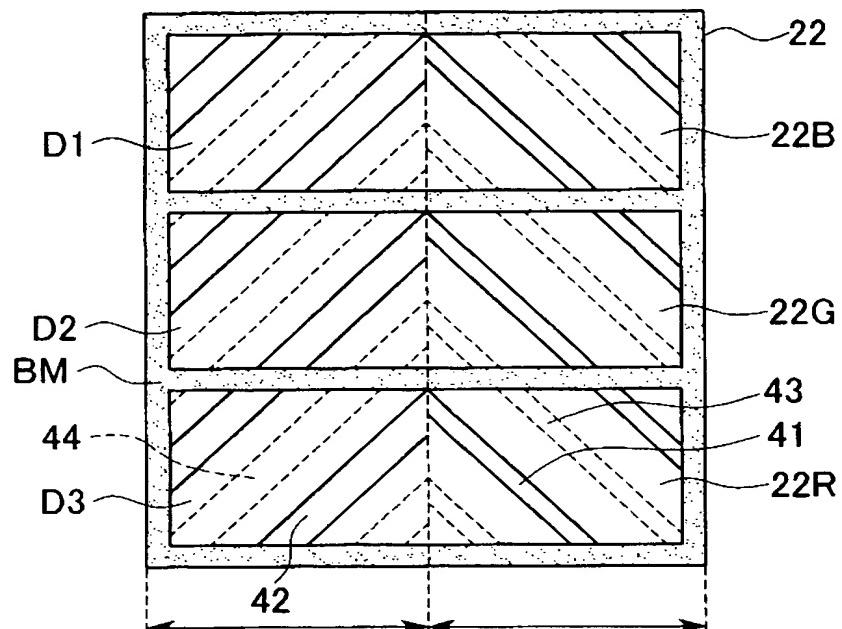


【図2】

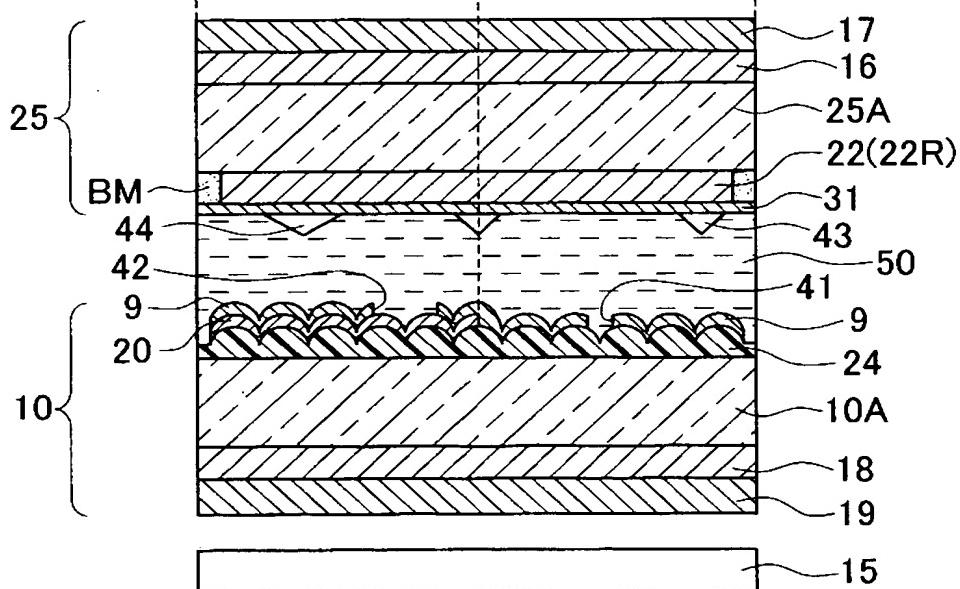


【図3】

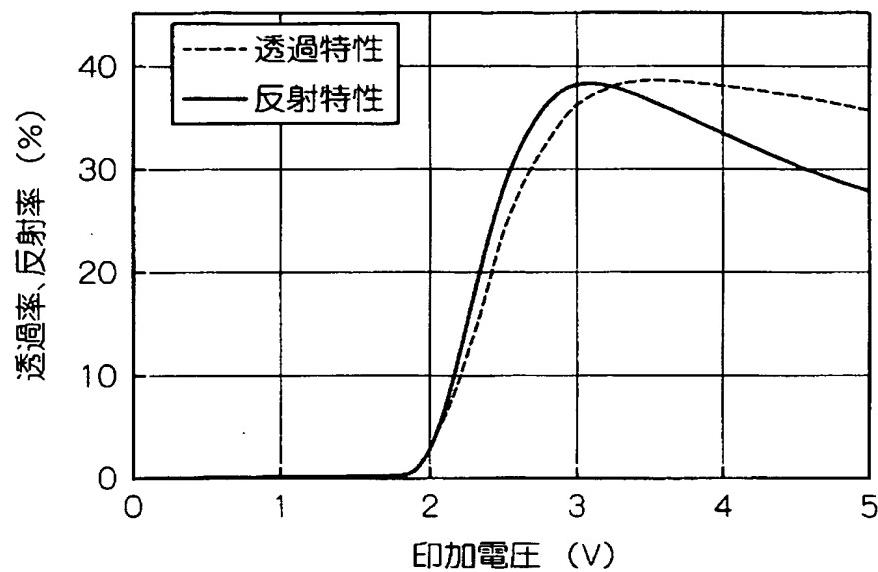
(a)



(b)

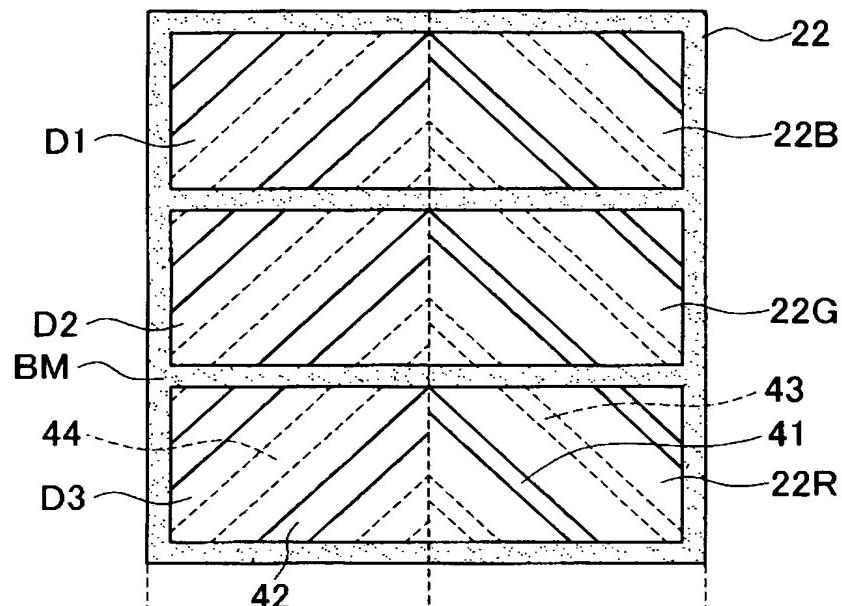


【図4】

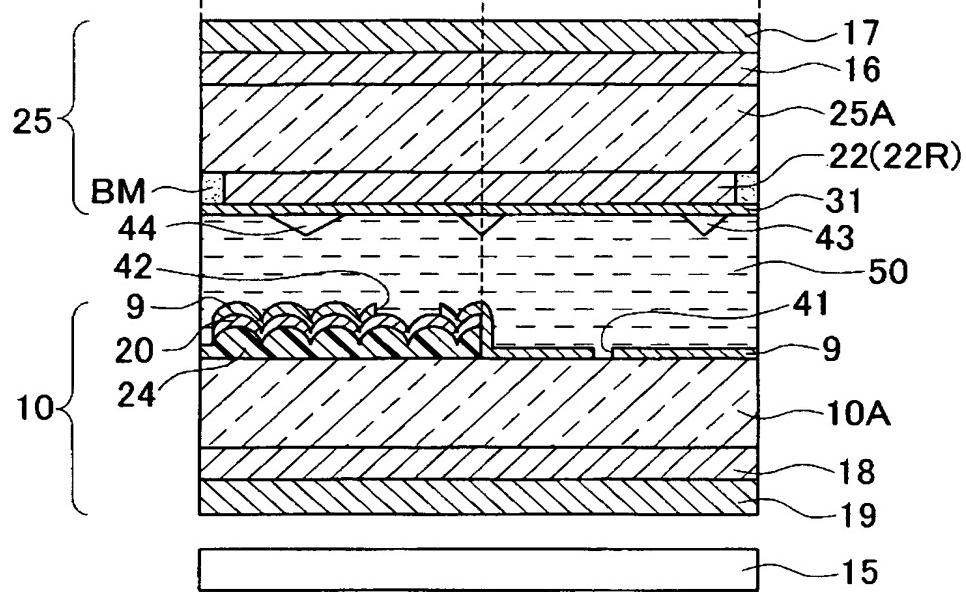


【図 5】

(a)

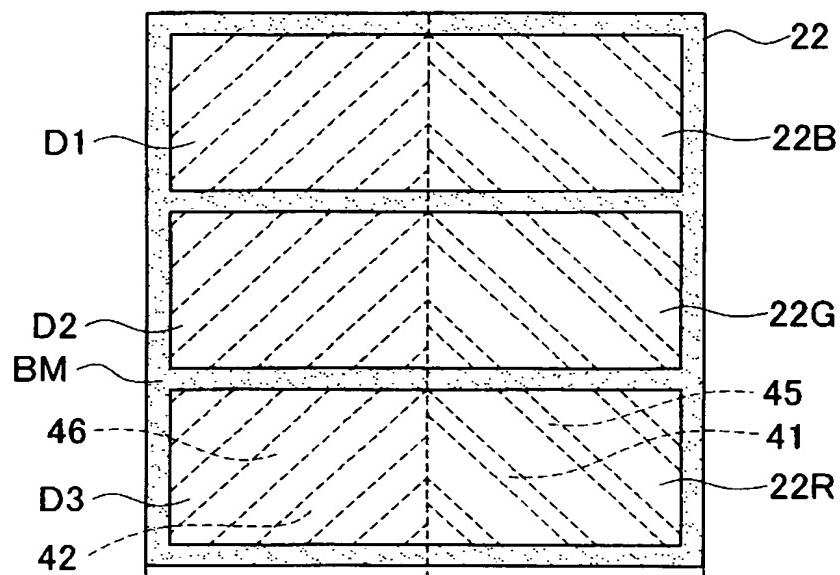


(b)

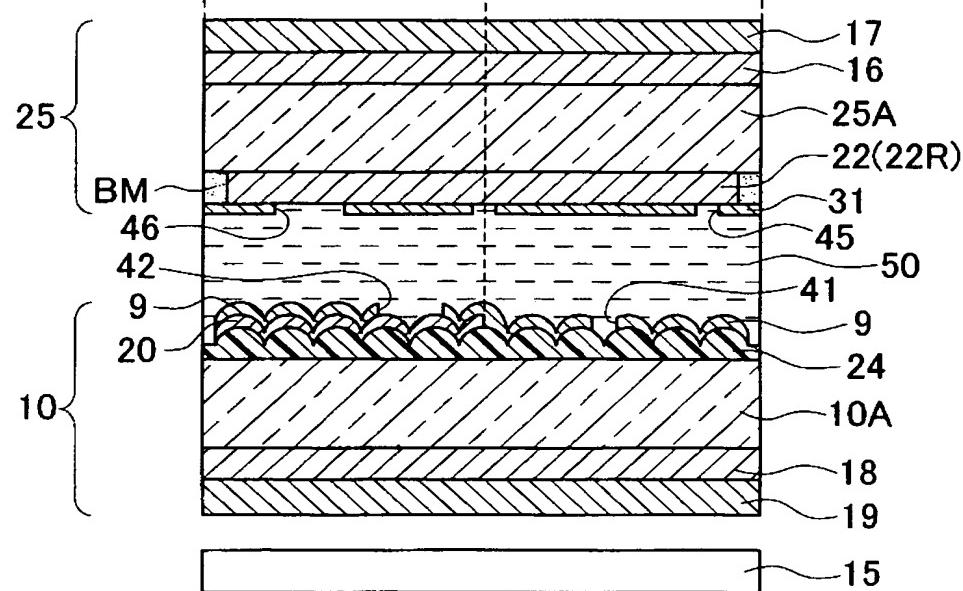


【図6】

(a)

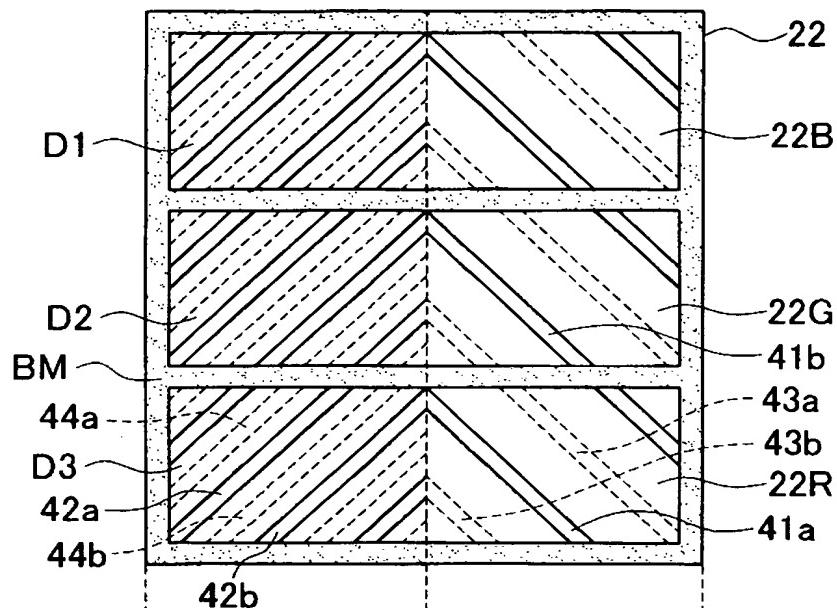


(b)

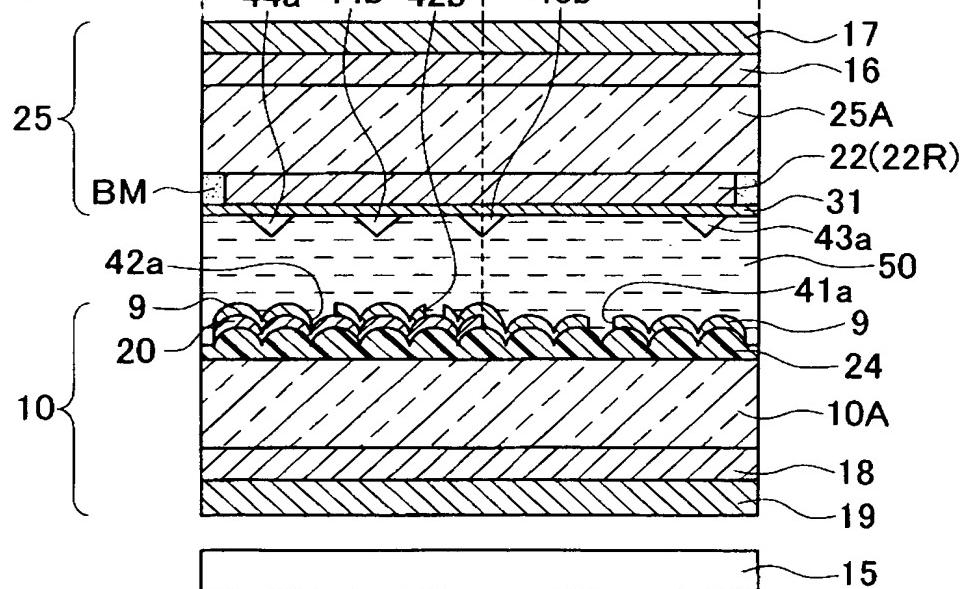


【図7】

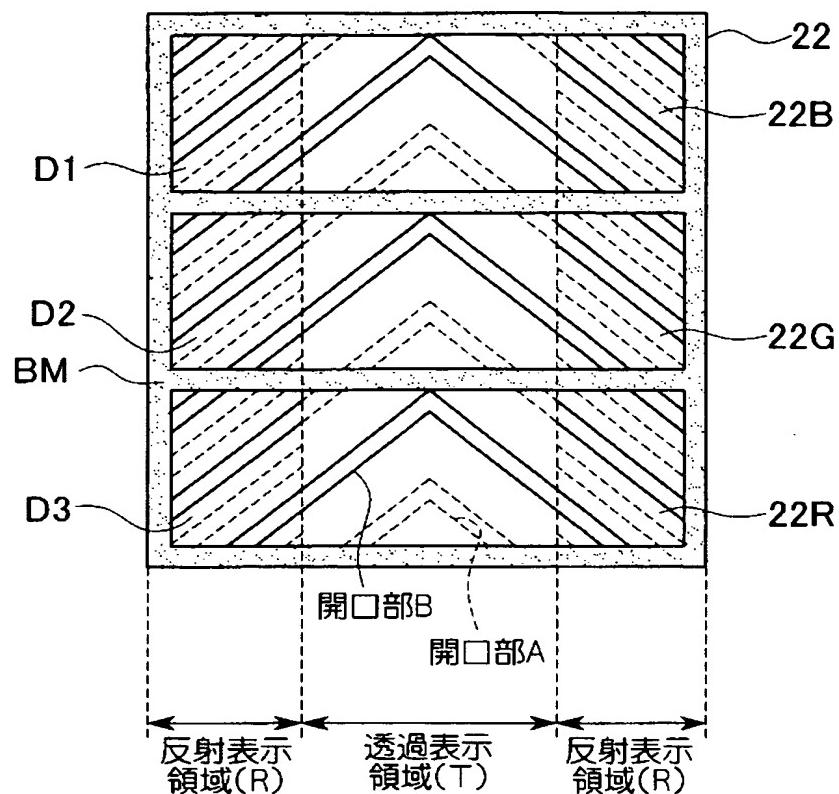
(a)



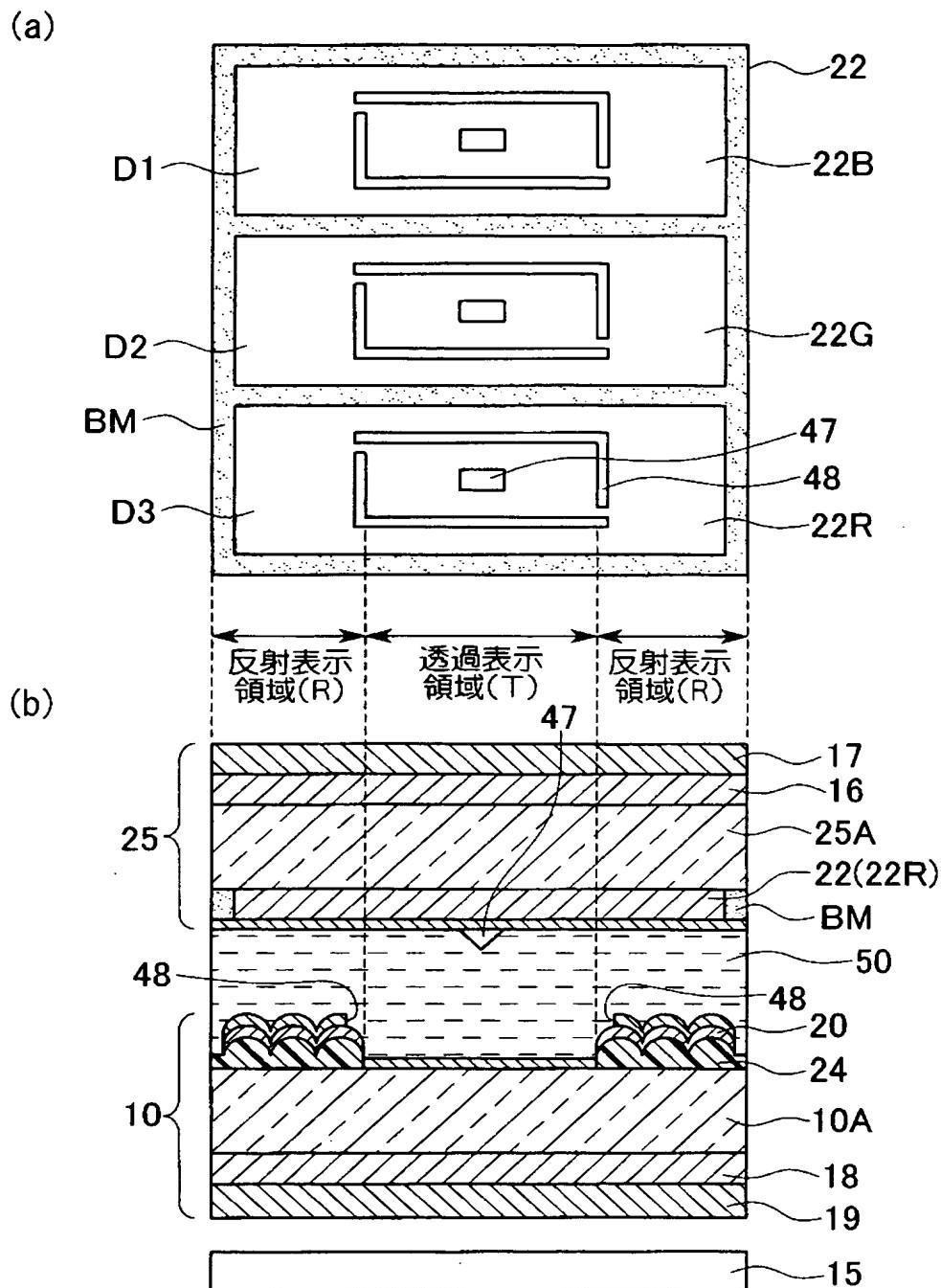
(b)



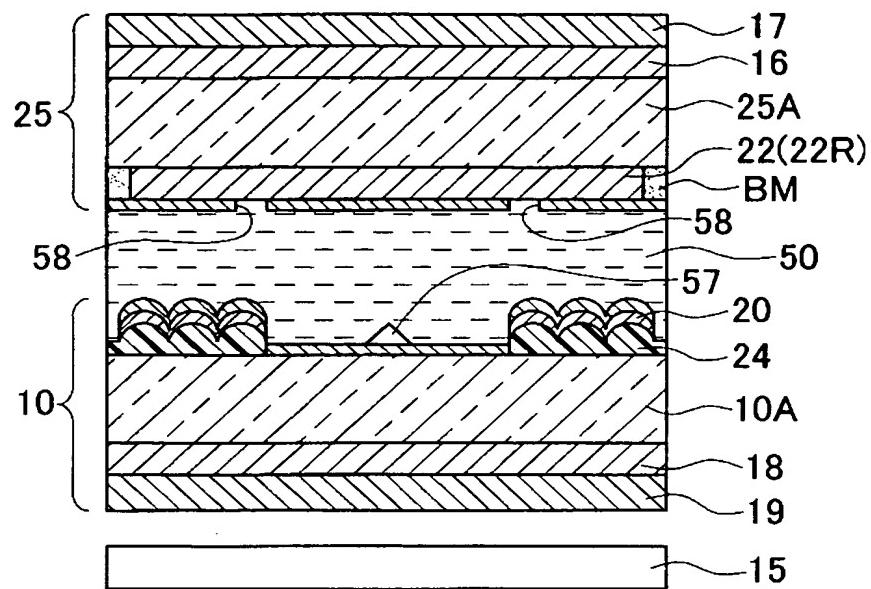
【図8】



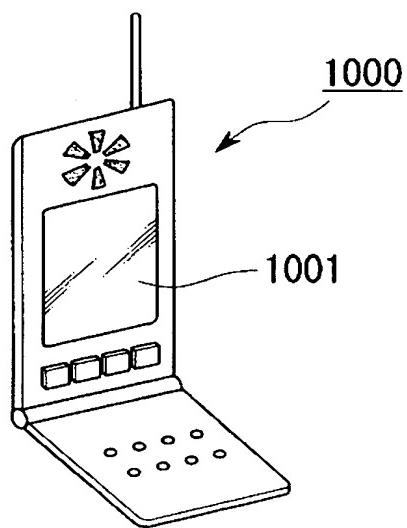
【図9】



【図10】

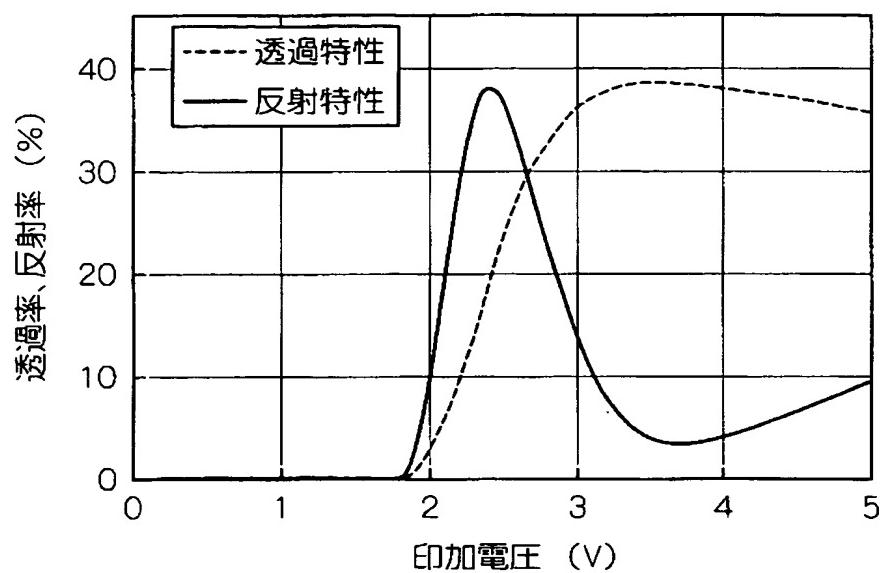


【図11】

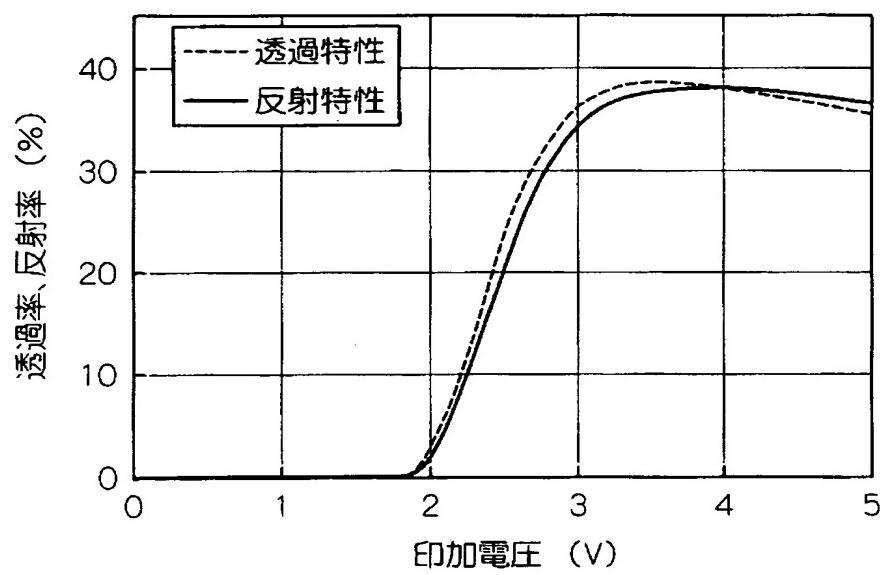


【図12】

(a)



(b)



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 半透過反射型液晶表示装置において、明るくコントラストが高く、さらには広視野角の表示を得ることが可能な液晶表示装置を提供する。

【解決手段】 本発明の液晶表示装置は、一対の基板10, 25間に液晶層50を挟持してなり、1つのドット領域D1内に透過表示領域Tと反射表示領域Rとを具備している。液晶層50は、初期配向状態が垂直配向を呈する誘電異方性が負の液晶からなり、一対の基板10, 25の液晶層50側には液晶を駆動するための電極9, 31が設けられている。そして、この電極9, 31には、透過表示領域T及び反射表示領域Rのそれぞれにおいて開口部41, 42、及び凸状部43, 44が設けられ、その開口部41, 42の開口面積、及び凸状部43, 44の基板平面方向占有面積が、透過表示領域Tよりも反射表示領域Rにおいて大きく構成されている。

【選択図】 図3

**認定・付加情報**

特許出願の番号	特願 2002-369954
受付番号	50201937038
書類名	特許願
担当官	大西 まり子 2138
作成日	平成 15 年 1 月 14 日

## &lt;認定情報・付加情報&gt;

## 【特許出願人】

【識別番号】	000002369
【住所又は居所】	東京都新宿区西新宿 2 丁目 4 番 1 号
【氏名又は名称】	セイコーエプソン株式会社

## 【代理人】

【識別番号】	100089037
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 OR ビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	渡邊 隆

## 【代理人】

【識別番号】	100064908
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 OR ビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	志賀 正武

## 【選任した代理人】

【識別番号】	100110364
【住所又は居所】	東京都新宿区高田馬場 3 丁目 23 番 3 号 OR ビル 志賀国際特許事務所
【氏名又は名称】	実広 信哉

次頁無

特願2002-369954

出願人履歴情報

識別番号 [000002369]

1. 変更年月日 1990年 8月20日

[変更理由] 新規登録

住 所 東京都新宿区西新宿2丁目4番1号  
氏 名 セイコーエプソン株式会社